

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-104040

(43)Date of publication of application : 11.04.2000

(51)Int.Cl.

C09J179/08
C09J 7/00
C09J163/00
C09J201/00
H01L 21/52

(21)Application number : 10-278509

(71)Applicant : HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 30.09.1998

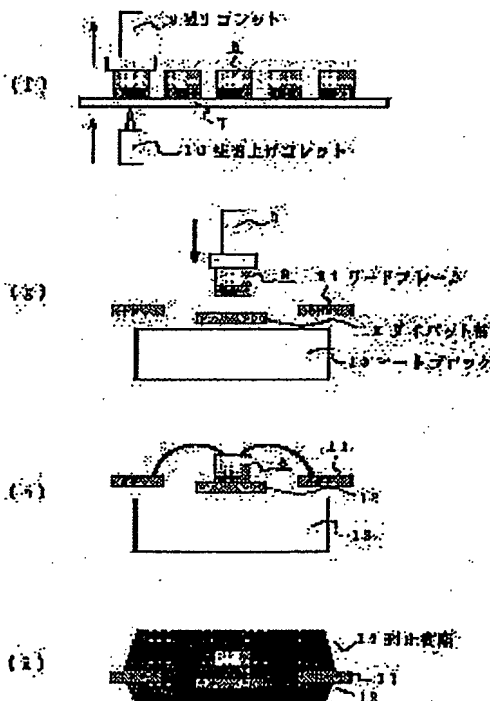
(72)Inventor : FUJII SHINJIRO

(54) ADHESIVE FOR DIE BONDING AND PREPARATION OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adhesive which does not cause cracks even in wafers having a thickness of not more than 300 μm and can be bonded to wafers over a wide range of temperature with small warpage in the thermocompression bonding of an adhesive to the back of a wafer and can effect die bonding with a simple apparatus, and a method for preparing semiconductor devices using this adhesive.

SOLUTION: A die bonding adhesive comprises a thermoplastic polyimide resin having a glass transition temperature of not higher than 90° C and a thermosetting resin, and a method for preparing a semiconductor device comprises thermocompressing a single-layer adhesive in the form of a film composed of a thermoplastic polyimide resin having a glass transition temperature of not higher than 90° C and a thermosetting resin on to the back of the wafer to obtain a wafer 8 with an adhesive, applying and fixing the resulting wafer with an adhesive to a dicing tape 7, dividing and cutting the dicing tape-bonded wafer with an adhesive into an individual semiconductor element, then peeling the dicing tape, and die-bonding the resulting semiconductor element 8 with an adhesive to a substrate member.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 29.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 05.08.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3605651

| | |
|--|-------------|
| [Date of registration] | 15.10.2004 |
| [Number of appeal against examiner's decision of rejection] | 2003-017089 |
| [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] | 04.09.2003 |
| [Date of extinction of right] | |

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2000-104040
(P2000-104040A)

(43)公開日 平成12年4月11日(2000.4.11)

| (51)Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テマコード [*] (参考) |
|-----------------------------|------|----------------|-------------------------|
| C 0 9 J 179/08 | | C 0 9 J 179/08 | Z 4 J 0 0 4 |
| 7/00 | | 7/00 | 4 J 0 4 0 |
| 163/00 | | 163/00 | 5 F 0 4 7 |
| 201/00 | | 201/00 | |
| H 0 1 L 21/52 | | H 0 1 L 21/52 | E |
| 審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全 9 頁) | | | |

(21)出願番号 特願平10-278509

(22)出願日 平成10年9月30日(1998.9.30)

(71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 藤井 真二郎

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
成工業株式会社山崎工場内

(74)代理人 100071559

弁理士 若林 邦彦

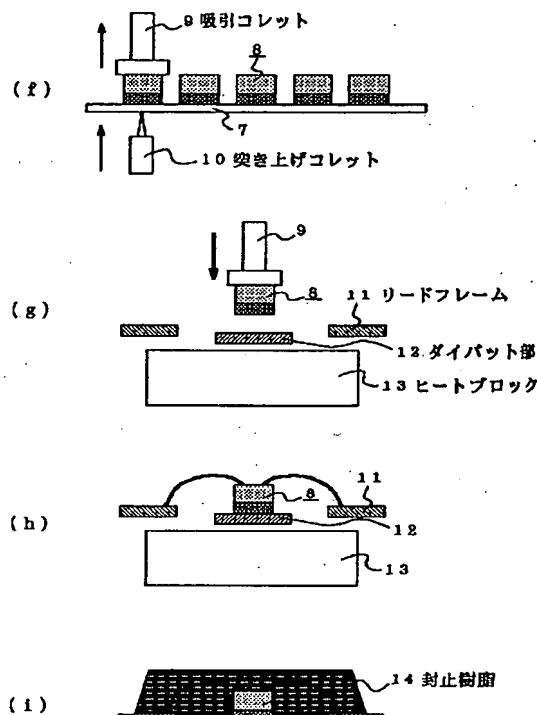
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ダイボンディング用接着剤及び半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 ウェハ裏面に接着剤を熱圧着する際、300 μ m以下のウェハでもクラックが発生せず、反りは小さく、また、幅広い温度で接着剤をウェハに接着でき、かつ簡単な装置でダイボンディングできる接着剤及びこの接着剤を用いた半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 ガラス転移温度90℃以下の熱可塑性ポリイミド樹脂及び熱硬化性樹脂を含有してなるダイボンディング用接着剤並びに多数の半導体素子が形成されたウェハ裏面に、ガラス転移温度90℃以下の熱可塑性ポリイミド樹脂と熱硬化性樹脂からなるフィルム状単層接着剤を熱圧着して接着剤付ウェハとし、得られた接着剤付ウェハをダイシングテープに貼り付け固着して個別半導体素子に分割切断後、前記ダイシングテープを剥離して得られる接着剤付き半導体素子を支持部材にダイボンディングすることを特徴とする半導体装置の製造方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス転移温度90℃以下の熱可塑性ポリイミド樹脂及び熱硬化性樹脂を含有してなるダイボンディング用接着剤。

【請求項2】 多数の半導体素子が形成されたウエハ裏面に、ガラス転移温度90℃以下の熱可塑性ポリイミド樹脂と熱硬化性樹脂からなるフィルム状単層接着剤を熱圧着して接着剤付ウエハとし、得られた接着剤付ウエハをダイシングテープに貼り付け固着して個別半導体素子に分割切断後、前記ダイシングテープを剥離して得られる接着剤付き半導体素子を支持部材にダイボンディングすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ダイボンディング用接着剤及びそれを用いた半導体装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、半導体素子のダイボンディング（半導体素子のリードフレームへの接合）方法としては、リードフレーム上のタブ部分にダイボンド材料を供給しその上に半導体素子載せ接着する方法が用いられてきた。これらのダイボンディング材料としては、例えばAu-Si共晶、半田、樹脂ペーストなどが知られている。これらダイボンディング材料のうち現在樹脂ペーストを用いるダイボンディング方法が多用されている。樹脂ペーストをリードフレームに供給する方法としては、スタンピング方式、ディスペンシング方式、スクリーン印刷方式が採用されているが、ディスペンシング方式が最もよく使われている。ディスペンシング方式は、シリンジ内に樹脂ペーストを充填し、ディスペンサーと呼ばれる装置による気圧でペーストをタブ上に吐出する方法である。しかしながら、当該法では半導体素子が大きくなるに従って樹脂ペーストをタブ全面に均等に塗布することが難しいという欠点があり、又樹脂ペーストを用いた場合、硬化時接着層にボイドが発生するという問題もある。

【0003】 一方、これらのペーストの欠点を避ける手法としてはフィルム状の接着剤を用いる方法として、特開昭63-289822号公報、特開平1-19735号公報に示されているが、素子のサイズに応じてフィルムを切断しなければならないこと、また、切断フィルムを位置ずれしないように貼り付ける専用の高価な装置が必要となる問題がある。

【0004】 さらに、この問題を解決する手法として、特開平6-302629号公報には、次のような方法が開示されている。まず、キャリアフィルム上に接着剤を膜状に塗布乾燥し、離型フィルムをかぶせて接着剤付きキャリアシートを作成し、離型フィルムをはがしてウ

て、接着剤付きウエハとする。接着剤付きウエハをダイシングテープ上に貼り付けた後、ダイシングをして接着剤付き半導体素子に分割する。接着剤付き半導体素子をダイシングテープから引き剥がしてリードフレームに熱圧着し、半導体素子をリードフレームに接着させる。

【0005】 しかしながら、本方法によれば、第1に、熱転写する温度は、キャリアフィルムの耐熱温度以上に設定できないため、接着剤をウエハに熱転写する温度が制限される問題がある。第二に、接着剤を熱転写する際、接着剤と積層しているキャリアフィルムが熱収縮するためウエハに大きな反りが生じる問題がある。反りが大きいとダイシングテープとの接着性の低い部分を生じやすく、ダイシングの際、半導体素子がダイシングテープより剥離してしまう。特に反りの生じやすい300μm以下のウエハなどに適用できるものを得ることは困難であった。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 請求項1記載の発明は、ウエハ裏面に接着剤を熱圧着する際、300μm以下のウエハでもクラックが発生せず、反りは小さく、また、幅広い温度で接着剤をウエハに接着でき、かつ簡単な装置でダイボンディングできる接着剤を提供するものである。請求項2に記載の発明はこの接着剤を用いた半導体装置の製造方法を提供するものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】 本発明は、ガラス転移温度90℃以下の熱可塑性ポリイミド樹脂と熱硬化性樹脂を含有してなるダイボンディング用接着剤に関する。本発明は、また、多数の半導体素子が形成されたウエハ裏面に、ガラス転移温度80℃以下の熱可塑性ポリイミド樹脂と熱硬化性樹脂からなるフィルム状単層接着剤を熱圧着して接着剤付ウエハとし、得られた接着剤付ウエハをダイシングテープに貼り付け固着して個別半導体素子に分割切断後、前記ダイシングテープを剥離して得られる接着剤付き半導体素子を支持部材にダイボンディングすることを特徴とする半導体装置の製造方法に関する。

【0008】

【発明の実施の形態】 以下、図1、図2により本発明の実施形態を説明する。図1はフィルム状単層接着剤をウエハ裏面に接着する工程からダイシングして接着剤付半導体素子とする工程の説明図である。図2はダイシングして接着剤付半導体素子をリードフレームタブ部に接着し、半導体装置を製造する工程の説明図である。

【0009】 図1において、接着剤1がポリエステルフィルム、ポリプロピレンフィルム等のキャリアフィルム2に積層され、ベースフィルム付接着フィルム3とされている(a)。単層接着剤は、このベースフィルム付接着フィルム3から、使用時にキャリアフィルム2を剥離することにより得られる。ベースフィルム付接着フィル

2, 3, 5, 6, 7-ヘキサヒドロナフタレン-1,
2, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、シクロペンタ
ン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸二無水物、ピロ
リジン-2, 3, 4, 5-テトラカルボン酸二無水物、
1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水
物、ビス(エキソ-ビスクロ〔2, 2, 1〕ヘプタン-
2, 3-ジカルボン酸二無水物)スルホン、ビスクロ-
(2, 2, 2)-オクト(7)-エン2, 3, 5, 6-
テトラカルボン酸二無水物、2, 2-ビス(3, 4-ジ
カルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン二無水
物、2, 2-ビス〔4-(3, 4-ジカルボキシフェノ
キシ)フェニル〕ヘキサフルオロプロパン二無水物、
4, 4'-ビス(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)ジ
フェニルスルフィド二無水物、1, 4-ビス(2-ヒド
ロキシヘキサフルオロイソプロピル)ベンゼンビス(トリ
メリット酸二無水物)、1, 3-ビス(2-ヒドロキ
シヘキサフルオロイソプロピル)ベンゼンビス(トリメ
リット酸二無水物)、5-(2, 5-ジオキソテトラヒ
ドロフリル)-3-メチル-3-シクロヘキセン-1,
2-ジカルボン酸二無水物、テトラヒドロフラン-2,
3, 4, 5-テトラカルボン酸二無水物等があり、2種
類以上を混合して用いてもよい。

【0015】前記ポリイミド樹脂の製造に使用されるジ
アミンとしては、1, 2-ジアミノエタン、1, 3-ジ
アミノプロパン、1, 4-ジアミノブタン、1, 5-ジ
アミノペンタン、1, 6-ジアミノヘキサン、1, 7-
ジアミノヘプタン、1, 8-ジアミノオクタン、1, 9-
ジアミノノナン、1, 10-ジアミノデカン、1, 11-
ジアミノウンデカン、1, 12-ジアミノドデカン
等の脂肪族ジアミン、o-フェニレンジアミン、m-
フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、3, 3'-
ジアミノジフェニルエーテル、3, 4'-ジアミノジ
フェニルエーテル、4, 4'-ジアミノジフェニルエー
テル、3, 3'-ジアミノジフェニルメタン、3, 4'-
ジアミノジフェニルメタン、4, 4'-ジアミノジフ
ェニルメタン、3, 3'-ジアミノジフェニルジフルオ
ロメタン、3, 4'-ジアミノジフェニルジフルオロメ
タン、4, 4'-ジアミノジフェニルジフルオロメタ
ン、3, 3'-ジ アミノジフェニルスルホン、3,
4'-ジアミノジフェニルスルホン、4, 4'-ジアミ
ノジフェニルスルホン、3, 3'-ジアミノジフェニル
スルフィド、3, 4'-ジアミノジフェニルスルフィ
ド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド、3,
3'-ジアミノジフェニルケトン、3, 4'-ジアミノ
ジフェニルケトン、4, 4'-ジアミノジフェニルケト
ン、2, 2-ビス(3-アミノフェニル)プロパン、
2, 2'- (3, 4'-ジアミノジフェニル)プロパ
ン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、
2, 2-ビス(3-アミノフェニル)ヘキサフルオロ

キサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェ
ニル)ヘキサフルオロプロパン、1, 3-ビス(3-ア
ミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(3-アミノ
フェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノフェ
ノキシ)ベンゼン、3, 3'- (1, 4-フェニレンビ
ス(1-メチルエチリデン))ビスアニリン、3, 4'-
 (1, 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデ
ン))ビスアニリン、4, 4'- (1, 4-フェニレン
ビス(1-メチルエチリデン))ビスアニリン、2, 2
-ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)プロ
パン、2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フ
ェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(3-アミノフ
ェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2
-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)ヘキ
サフルオロプロパン、ビス(4-(3-アミノフェノキ
シ)フェニル)スルフィド、ビス(4-(4-アミノフ
ェノキシ)フェニル)スルホン、ビス(4-(4
-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン等の芳香族ジ
アミンを挙げることができる。

【0016】テトラカルボン酸二無水物とジアミンの縮
合反応は、有機溶媒中で行う。この場合、テトラカルボ
ン酸二無水物とジアミンは等モル又はほぼ等モルで用い
るのが好ましく、各成分の添加順序は任意である。用い
る有機溶媒としては、ジメチルアセトアミド、ジメチル
ホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチル
スルホキシド、ヘキサメチルホスホリルアミド、m-ク
レゾール、o-クロルフェノール等がある。反応温度は
80℃以下、好ましくは0～50℃である。反応が進行
するにつれ反応液の粘度が徐々に上昇する。この場合、
ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸が生成する。

【0017】ポリイミドは、上記反応物(ポリアミド
酸)を脱水閉環させて得ることができる。脱水閉環は1
20℃～250℃で熱処理する方法や化学的方法を用い
て行うことができる。120℃～250℃で熱処理する
方法の場合、脱水反応で生じる水を系外に除去しながら
行うことが好ましい。この際、ベンゼン、トルエン、キ
シレン等を用いて水を共沸除去してもよい。なお、本発
明においてポリイミド樹脂とは、ポリイミド及びその前
駆体を総称する。ポリイミドの前駆体には、ポリアミド
酸のほか、ポリアミド酸が部分的にイミド化したものが
ある。

【0018】化学的方法で脱水閉環させる場合は、閉環
剤として無水酢酸、無水プロピオン酸、無水安息香酸の
酸無水物、ジシクロヘキシルカルボジイミド等のカルボ
ジイミド化合物等を用いる。このとき必要に応じてピリ
ジン、イソキノリン、トリメチルアミン、アミノピリジ
ン、イミダゾール等の閉環触媒を用いてもよい。閉環剤
又は閉環触媒は、テトラカルボン酸二無水物1モルに対

い。

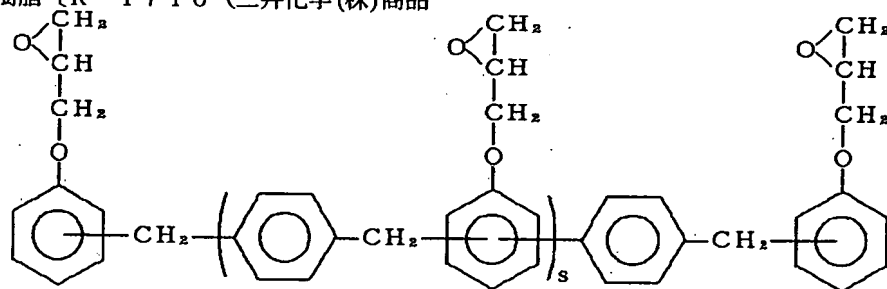
【0019】前記熱硬化性樹脂とは、加熱により3次元網目構造を形成し、硬化する樹脂のことである。熱硬化性樹脂の配合量は、熱可塑性ポリイミド樹脂100重量部に対し0.1~200重量部、好ましくは1~100重量部とする。200重量部を越えるとフィルム形成性が悪くなる。

【0020】熱硬化性樹脂として、エポキシ樹脂、硬化剤及び硬化促進剤を含有する樹脂を選ぶ場合に、用いられるエポキシ樹脂は、分子内に少なくとも2個のエポキシ基を含むもので、硬化性や硬化物特性の点からフェノールのグリシジルエーテル型のエポキシ樹脂が好ましい。このような樹脂としては、ビスフェノールA、ビスフェノールAD、ビスフェノールS、ビスフェノールFもしくはハロゲン化ビスフェノールAとエピクロロヒドリンの縮合物、フェノールノボラック樹脂のグリシジルエーテル、クレゾールノボラック樹脂のグリシジルエーテル、ビスフェノールAノボラック樹脂のグリシジルエーテル等が挙げられる。エポキシ樹脂の量は、ポリイミド樹脂100重量部に対し1~200重量部、好ましくは5~100重量部で、200重量部を越えるとフィルム形成性が悪くなる。

【0021】前記エポキシ樹脂としては、例えばビスフェノールA型エポキシ樹脂〔AER-X8501（旭化成工業(株)商品名）、R-301（油化シェルエポキシ(株)商品名）、YL-980（油化シェルエポキシ(株)商品名）〕、ビスフェノールF型エポキシ樹脂〔YDF-170（東都化成(株)商品名）〕、ビスフェノールAD型エポキシ樹脂〔R-1710（三井化学(株)商品

名）、EXA-830CRP（大日本インキ化学工業(株)商品名）〕、フェノールノボラック型エポキシ樹脂〔N-730S（大日本インキ化学工業(株)商品名）、Quatrex-2010（ダウ・ケミカル社商品名）〕、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂〔YDCN-702S（東都化成(株)商品名）、EOCN-100（日本化薬(株)商品名）〕、多官能エポキシ樹脂〔EPPN-501（日本化薬(株)商品名）、TACTIX-742（ダウ・ケミカル社商品名）、VG-3010（三井化学(株)商品名）、1032S（油化シェルエポキシ(株)商品名）〕、ナフタレン骨格を有するエポキシ樹脂〔HP-4032（大日本インキ化学工業(株)商品名）〕、脂環式エポキシ樹脂〔CEL-3000（ダイセル化学工業(株)商品名）〕、エポキシ化ポリブタジエン〔PB-4700（ダイセル化学工業(株)商品名）〕、アミン型エポキシ樹脂〔ELM-100（住友化学工業(株)商品名）、YH-434L（東都化成(株)商品名）〕、レゾルシン型エポキシ樹脂〔デナコールEX-201（ナガセ化成工業(株)商品名）〕、ネオペンチルグリコール型エポキシ樹脂〔デナコールEX-211（ナガセ化成工業(株)商品名）〕、ヘキサندیネグリコール型エポキシ樹脂〔デナコールEX-212（ナガセ化成工業(株)商品名）〕、エチレン・プロピレングリコール型エポキシ樹脂〔デナコールEX-810, 811, 850, 851, 821, 830, 832, 841, 861（ナガセ化成工業(株)商品名）〕、下記一般式（I）

【化1】



(I)

〔式中sは0~5の整数を表す〕で表されるエポキシ樹脂〔E-XL-24, E-XL-3L（三井化学(株)商品名）〕などが挙げられる。これらは単独で又は2種以上を組み合わせ使用することができる。

【0022】PGE（日本化薬(株)商品名）、PP-101（東都化成(株)商品名）、ED-502, 509（旭電化工業(株)商品名）、YED-122（油化シェルエポキシ(株)商品名）、KBM-403（信越化学工業(株)商品名）、TSL-8350, TSL-8355, TSL-9905（東芝シリコン(株)商品名）等の1分子中に1個のエポキシ基を有する化合物（単官能

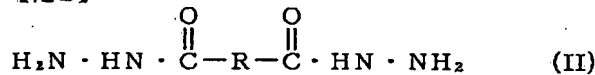
もよい。単官能エポキシ化合物は、本発明の樹脂ベース組成物の特性を阻害しない範囲で使用されるが、エポキシ樹脂の全量に対して10重量%以下で使用されることが好ましい。

【0023】硬化剤としては、例えば、フェノール樹脂が用いられる。フェノール樹脂は、分子中に少なくとも2個のフェノール性水酸基を有するもので、このような樹脂としては、例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ビスフェノールAノボラック樹脂、ポリ-p-ビニルフェノール、フェノールアラールキル樹脂等が挙げられる。フェノール樹脂の量は、エポ

しくは50~120重量部で、2重量部未満もしくは150重量部を越えると硬化性が不充分となる。

【0024】硬化剤としては、また、ジシアンジアミド、下記一般式 (II)

【化2】



【式中、Rは、m-フェニレン基、p-フェニレン基等の2価の芳香族基、炭素数2~12の直鎖状又は分枝状のアルキレン基を表す】で示される二塩酸ジヒドラジド〔市販品としては、ADH、PDH、SDH（いずれも日本ヒドラジン工業(株)商品名）がある〕、エポキシ樹脂とアミン化合物の反応物〔市販品としてはノバキュア（マイクロカプセル型硬化剤、旭化成工業(株)商品名）がある〕等が挙げられる。このようなエポキシ樹脂硬化剤の配合量は、エポキシ樹脂に対して0.01~90重量%が好ましく、0.1~50重量%がより好ましい。

【0025】硬化促進剤は、エポキシ樹脂を硬化させるために用いられるものであれば特に制限はない。このようなものとしては例えば、イミダゾール類、ジシアンジアミド誘導体、ジカルボン酸ジヒドラジド、トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、2-エチル-4-メチルイミダゾール-テトラフェニルボレート、1, 8-ジアザビシクロ

(5, 4, 0) ウンデセン-7-テトラフェニルボレート等が用いられる。これらは、2種以上を併用してもよい。硬化促進剤の量はエポキシ樹脂100重量部に對し、0.01~50重量部、好ましくは0.1~20重量部で、0.01重量部未満では、硬化性が不充分となり、50重量部を越えると保存安定性が悪くなる。

【0026】接着力を向上させるため、接着剤にシランカップリング剤、チタン系カップリング剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、シリコン系添加剤等を適宜加えてもよい。

【0027】本発明でウエハに貼り付ける条件としては、接着フィルムのガラス転移温度T_g（動的粘弾性測定における緩和ピーク温度）以上で熱分解温度（熱重量分析における重量減少開始温度）以下が好ましい。フィルム圧着温度がT_g未満では、貼り付け性が低下するので好ましくない。120℃から200℃が好ましい。ウエハに貼り付ける圧力は、0.03MPa~2MPaが好ましい。0.03MPa未満では圧力が弱すぎてボイドが残留してしまい、2MPaを超えると圧力が強すぎてウエハが割れる心配があるからである。本発明に用いるウエハとしては、シリコンウエハ、化合物ウエハなどがあり、特に限定されない。

【0028】接着剤付半導体素子をリードフレーム等の

高い温度で熱分解温度以下であることが好ましい。接着剤付半導体素子の接着温度がT_gから70℃高い温度より低い温度であると接着性が低下し、熱分解温度を超えるとフィルム状接着剤が熱分解し接着力が低下するので好ましくない。温度は160℃から240℃が好ましい。また、圧力は0.03MPa~2MPaが好ましい。0.03MPa未満では圧力が弱すぎてボイドが残留してしまい、2MPaを超えると圧力が強すぎて半導体素子が割れる心配があるからである。

【0029】本発明で接着剤付半導体素子を圧着する支持部材としては、リードフレームのダイパット部、セラミック配線板、ガラスエポキシ配線板、ポリイミド配線板、半導体素子上部等の半導体素子搭載部が挙げられる。

【0030】

【実施例】以下、本発明を実施例により詳しく説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。以下、「部」は、「重量部」を意味する。

【0031】実施例1

熱可塑性ポリイミド〔ガラス転移温度70℃、デカメチレンビストリメリテート二無水物1モルに対して4, 9-ジオキサドデカン-1, 12-ジアミン0.5モル、2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン0.5モルを反応させて得られるもの〕100部及びビスフェノールA型エポキシ樹脂(EXA-830CRP、大日本インキ化学工業株式会社商品名、エポキシ当量175)5部、硬化剤フェノールノボラック樹脂(H-1、昭和化成株式会社商品名)5部にシクロヘキサノンとジメチルアセトアミドの等重量混合溶剤280部を加えて溶解させる。ここに、銀粉を70部加えて、よく攪拌し、均一に分散させ、塗工用ワニスとする。この塗工用ワニスをキャリアフィルム(ポリプロピレン)上に塗工し、熱風循環式乾燥機の中で加熱して、溶媒を揮発乾燥させ、キャリアフィルムから剥離して、フィルム状単層接着剤を製造した。

【0032】フィルム状単層接着剤をウエハのサイズよりも大きめに切り、ウエハ裏面を上にして、フィルム状接着剤を載せ0.15MPaで加圧、180℃で加熱することにより、フィルム状接着剤付きウエハを得た。フィルム状接着剤付きウエハは、約30秒間180℃で加熱し、残存揮発分を除いた。その後、ウエハに接着後のウエハ(5インチ)の外観を観察し、また、反りを測定した。フィルム状接着剤付きウエハの接着面にダイシングテープを貼付し、ダイシング装置でフルカットすることにより接着剤付き半導体素子へ分割し、展張した。

【0033】ダイシングテープ上に分割された接着剤付き半導体素子はダイボンダーによりダイシングテープの下からピンで突き上げられ、吸引コレットにより引き剥がされた。リードフレームへ、温度220℃、荷重50

化成工業株式会社製封止材（商品名CEL9200）でモールドし半導体装置とした。封止後のサンプルを85℃、85%RHの恒温恒湿器中で168時間処理した後、IRリフロー炉で240℃、10sec加熱する。その後、サンプルをポリエステル樹脂で注型し、ダイヤモンドカッターで切断した断面を顕微鏡で観察して、リフロークラックの発生数を評価する事により耐リフロークラック性の評価を行った。評価結果を表1に示す。

【0034】実施例2

熱可塑性ポリイミドとして、熱可塑性ポリイミド〔ガラス転移温度50℃、デカメチレンビストリメリテート二無水物1モルに対して4, 9-ジオキサデカン-1, 12-ジアミン1モルを反応させて得られるもの〕を使用したこと以外は実施例1に準じて行った。評価結果を表1に示す。

【0035】比較例1

熱可塑性ポリイミド〔ガラス転移温度120℃、デカメチレンビストリメリテート二無水物1モルに対して2, 2-ビス（4-（4-アミノフェノキシ）フェニル）プロパン1モルを反応させて得られるもの〕100部、実施例1と同じビスフェノールAD型エポキシ樹脂（エポキシ当量175）5部及び実施例1と同じ硬化剤フェノールノボラック樹脂5部に有機溶媒280部を加えて溶解させた。ここに、銀粉を70部加えて、よく攪拌し、均一に分散させ、塗工用ワニスとした。この塗工用ワニスをキャリアフィルム（ポリエチレンテレフタレート）上に塗工し、熱風循環式乾燥機の中で加熱して、溶媒を揮発乾燥させ、キャリアフィルム付きフィルム状接着剤を製造した。

【0036】キャリアフィルム付きフィルム状接着剤をウェーハのサイズよりも大きめに切り、ウェーハ裏面を上にし、そこへ、キャリアフィルム付きフィルム状接着剤を載せ0.15MPaで加圧、150℃～180℃で加熱することにより、キャリアフィルム付きフィルム状接着剤付きウェーハを得た。キャリアフィルムを剥離した後、フィルム状接着剤付きウェーハは、約30秒間150℃～180℃で加熱し、残存揮発分を除いた。その後、ウェーハに接着後のウェーハ（5インチ）の外観を観察し、また、反りを測定した。フィルム状接着剤付きウェーハの接着剤面にダイシングテープを貼付、ダイシング装置でフルカットすることにより接着剤付き半導体素子へ分割し、展張した。

【0037】ダイシングテープ上に分割された接着剤付き半導体素子はダイボンダーによりダイシングテープの下からピンで突き上げられ、吸引コレットにより引き剥がされた。リードフレームへ、温度220℃、荷重50

g、時間5秒で接着剤付きチップをマウントする。日立化成工業株式会社製封止材（商品名CEL9200）でモールドし半導体装置とする。封止後のサンプルを85℃、85%RHの恒温恒湿器中で168時間処理した後、IRリフロー炉で240℃、10sec加熱する。その後、サンプルをポリエステル樹脂で注型し、ダイヤモンドカッターで切断した断面を顕微鏡で観察して、リフロークラックの発生数を評価することにより耐リフロークラック性の評価を行った。評価結果を表1に示す。

【0038】比較例2

比較例1と同じ熱可塑性ポリイミド100部、実施例1と同じビスフェノールAD型エポキシ樹脂（エポキシ当量175）5部及び実施例1と同じ硬化剤フェノールノボラック樹脂5部にシクロヘキサノンとジメチルアセトアミドの等重量混合溶剤280部を加えて溶解させた。ここに、銀粉を70部加えて、よく攪拌し、均一に分散させ、塗工用ワニスとする。この塗工用ワニスをキャリアフィルム（ポリプロピレン）上に塗工し、熱風循環式乾燥機の中で加熱して、溶媒を揮発乾燥させ、キャリアフィルムから剥離して、フィルム状単層接着剤を製造した。

【0039】フィルム状単層接着剤をウェーハのサイズよりも大きめに切り、ウェーハ裏面を上にして、フィルム状接着剤を載せ0.15MPaで加圧、180℃で加熱することにより、フィルム状接着剤付きウェーハを得た。フィルム状接着剤付きウェーハは、約30秒間180℃で加熱し、残存揮発分を除いた。その後、ウェーハに接着後のウェーハ（5インチ）の外観を観察し、また、反りを測定した。フィルム状接着剤付きウェーハの接着剤面にダイシングテープを貼付、ダイシング装置でフルカットすることにより接着剤付き半導体素子へ分割し、展張した。

【0040】ダイシングテープ上に分割された接着剤付き半導体素子はダイボンダーによりダイシングテープの下からピンで突き上げられ、吸引コレットにより引き剥がされる。リードフレームへ、温度220℃、荷重50g、時間5秒で接着剤付きチップをマウントする。日立化成工業株式会社製封止材（商品名CEL9200）でモールドし半導体装置とした。封止後のサンプルを85℃、85%RHの恒温恒湿器中で168時間処理した後、IRリフロー炉で240℃、10秒加熱した。その後、サンプルをポリエステル樹脂で注型し、ダイヤモンドカッターで切断した断面を顕微鏡で観察して、リフロークラックの発生数を評価する事により耐リフロークラック性の評価を行った。結果を表1に示す。

【0041】

【表1】

表 1 評価結果

| No. | 実施例1 | 実施例2 | 比較例1 | 比較例2 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 熱可塑性樹脂 T _g (°C) | 70 | 50 | 120 | 120 |
| ダイシング時の半導体素子剥離率% | 0 | 0 | 30 | 5 |
| キャリアフィルム | なし | なし | あり | なし |
| 接着層のボイドの有無 | なし | なし | あり | なし |
| ウェハ反り (5インチ発生率/厚さ300 μ m) | 50 | 50 | 350 | 150 |
| リフロックラック (%) | 0 | 0 | 70 | 0 |

【0042】

【発明の効果】請求項1における接着剤を用い、請求項2の方法によれば、フィルム状ウェハ裏面に接着剤を熱圧着する際、300 μ m以下のウェハでも反りは小さく、また、幅広い温度で接着剤をウェハに接着でき、また、接着層にボイドが無く耐リフロー性に優れた半導体装置を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

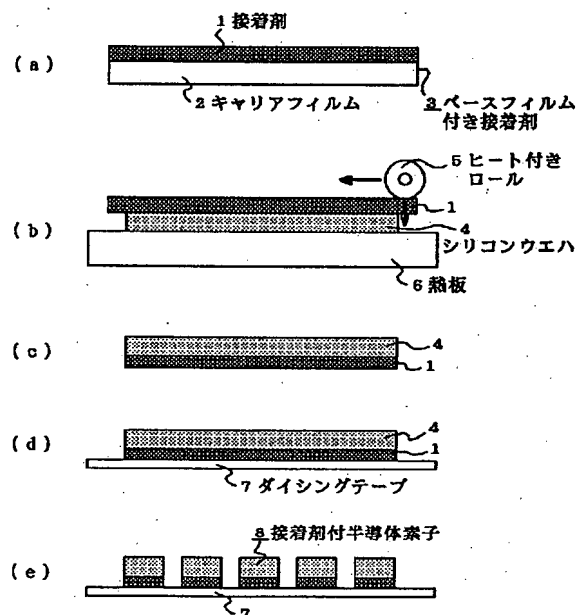
【図1】フィルム状接着剤をウェハ裏面に接着する工程からダイシングして接着剤付半導体素子とする工程説明図である。

【図2】ダイシングして接着剤付半導体素子をリードフレームに接着し、半導体装置を製造する工程説明図である。

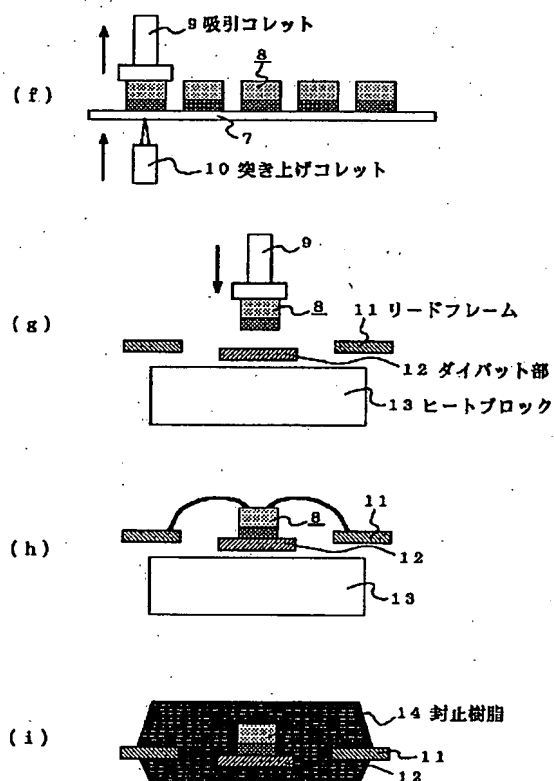
【符号の説明】

- 1 接着剤
- 2 キャリアフィルム
- 3 ベースフィルム付き接着剤
- 4 シリコンウェハ
- 5 ヒート付きロール
- 6 熱板
- 7 ダイシングテープ
- 8 接着剤付半導体素子
- 9 吸引コレット
- 10 突き上げコレット
- 11 リードフレーム
- 12 ダイパット部
- 13 ヒートブロック
- 14 封止樹脂

【図1】



【図2】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4J004 AA02 AA11 AA13 AA17 AB03
AB05 CA04 CA06 CC02 FA05
FA08
4J040 EB032 EC061 EC062 EC071
EC072 EC151 EC152 EC332
EH031 EH032 HC15 HC18
HC24 HD22 HD39 JA09 JB02
KA16 KA17 LA02 LA06 NA20
PA30 PA33
5F047 BA39 BB03 BB18 FA08 FA25

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-195828

(43)Date of publication of application : 14.07.2000

(51)Int.Cl.

H01L 21/301

(21)Application number : 10-369945

(71)Applicant : DENSO CORP

(22)Date of filing : 25.12.1998

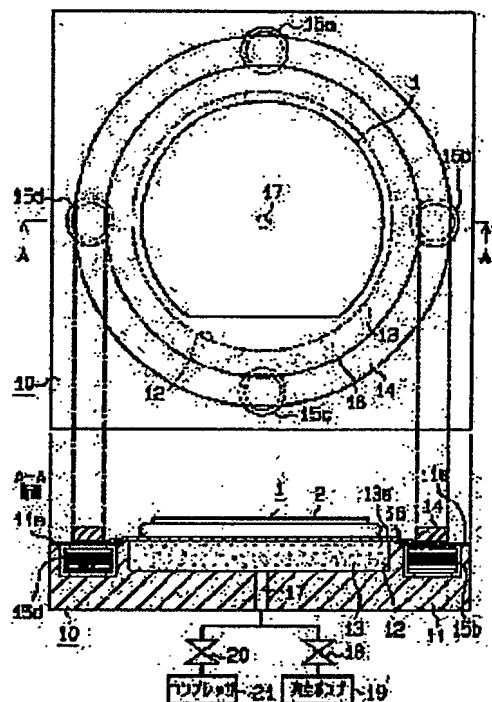
(72)Inventor : KANO FUMYOSHI
NAGAYA MASATAKE
YAMAGUCHI MASATO

(54) METHOD AND DEVICE FOR CUTTING/SEPARATING WAFER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and a device for cutting/separating a wafer, with which throughput is increased surely by suppressing chipping, etc.

SOLUTION: A wafer-mounting table 10 comprises a wafer-mounting surface 13a, and an adhesive tape 16 is stretched in the wafer-mounting surface 13a. Gas can be supplied between the wafer-mounting surface 13a of the wafer-mounting table 10 and the adhesive tape 16 through an air path 17. Under a condition where a silicon wafer 1 stuck on the adhesive tape 16 is half-cut, air is supplied through the air path 17 to between the adhesive tape 16 and the wafer-mounting surface 13a with the use of a compressor 21, to inflate the adhesive tape 16, so that the silicon wafer 1 is cut/separated into each chip.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]